# 2SA1037K/2SA1576

*T-27-09* 

トランジスタ

# 2SA1037K 2SA1576

● 特長

1) 低雑音である。 NF=0.5dB Typ.

2) 2SC2412K/2SC4081とコンプリである。

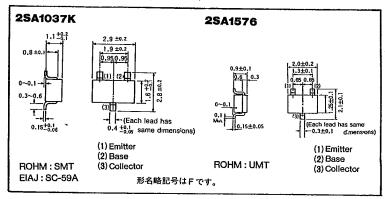
#### Features

- 1) Low noise: NF=0.5dB (Typ.)
- 2) Complementary pair with 2SC2412K/2SC4081.

エピタキシァルプレーナ形スーパー/ウルトラミニモールド PNP シリコントランジスタ

一般小信号增幅用/General Small Signal Amp. Epitaxial Planar Super/Ultra Mini-Mold PNP Silicon Transistors

● 外形寸法図/Dimensions (Unit:mm)



## ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CBO</sub>	-50	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	-40	٧	
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	-5	V	
コレクタ電流	lo	-100	mA	
コレクタ損失	Po	200	mW	
接合部温度	Tj	125	°C	
保存温度範囲	Tstg	-55~125	°C	

#### ● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BVCEO	40	_	_	V	Ic=-1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV <sub>CBO</sub>	-50		_	V	Ic=-50 µA
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	<b>–</b> 5	-		V	I <sub>E</sub> =-50 μA
コレクタしゃ断電流	Ісво			-0.5	μА	V <sub>CB</sub> =-30V
エミッタしゃ断電流	IEBO			-0.5	μΑ	V <sub>EB</sub> =-4V
直流電流増幅率	hFE	120	_	560	_	Vce /lc=-6V/-1mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)		_	-0.5	V	Ic/IB=-50mA/-5mA
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f <sub>T</sub>	_	140		MHz	Vce =-12V, I ==2mA
コレクタ出力容量	Cob		3.5	<del>-</del>	pF	V <sub>CB</sub> =-12V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz

## hfeの値により下表のように分類します。

Item	Q	R	\$ 270~560	
h FE	120~270	180~390		

# 標準品・準標準品一覧表

準標準品一覧表 (◎:標準品 ○:準標準品) 						
	包装名	テーピング				
	記号	T146	T147	T106	T107	
hFE	基本発注単位(個)	3 000	3 000	3 000	3 000	
QRS		0	0	_	_	
QRS			_	0	0	

ROHM

Туре

2SA1037K

2SA1576

139

T-27-09

#### ● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

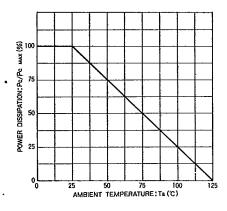


Fig.1 電力軽減曲線

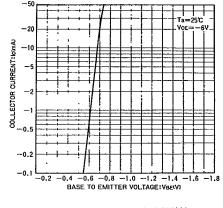


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

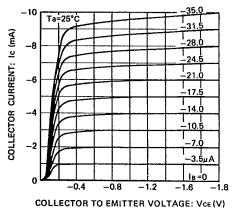


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

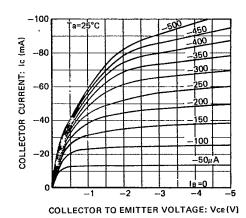


Fig.4 エミッタ接地出力静特性(Ⅱ)

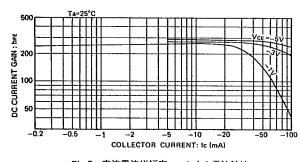


Fig.5 直流電流増幅率 - コレクタ電流特性

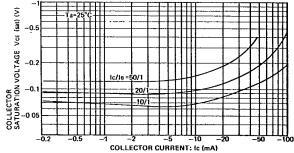


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧 -- コレクタ電流特性

140

TT KEN

# トランジスタ/Transistors

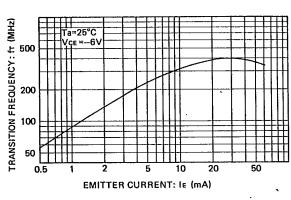
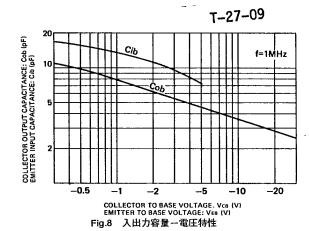
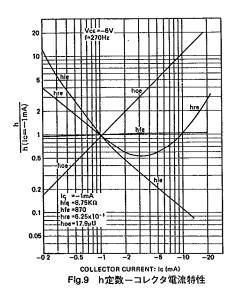


Fig.7 利得帯域幅積--エミッタ電流特性







ROHM

141